

## Учебно-научная лаборатория "Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках"

Объекты исследований: полупроводниковые кристаллы: карбид кремния, нитрид галлия, германий, антимонид индия; полупроводниковый полосковый гетеролазер с квантовой ямой, германиевый фотодиод.

Методы исследования: отражение, люминесценция, поглощение, фотопроводимость, эффект Холла.

Оборудование в составе исследовательских комплексов: осциллограф, синхронный фазочувствительный усилитель (Lock-in-amplifier), селективный усилитель, обтюратор, модель абсолютно черного тела, криостат с жидким азотом.

